

关键指标

频率: 6~20GHz
增益: 20dB
1dB 压缩点输出功率: 18dBm
输出功率: 19.5dBm@Pin=2dBm
电压/静态电流: +5V/105mA
芯片尺寸: 1.45mm×1mm

产品简介

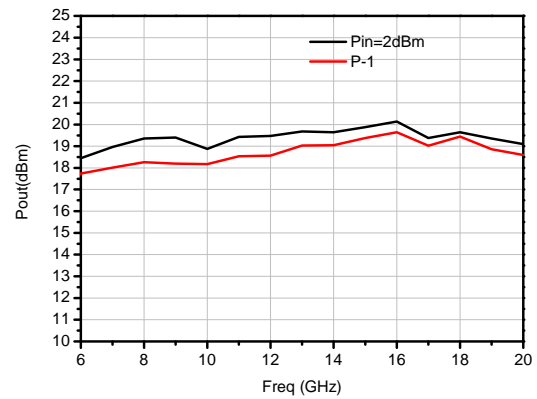
HG126F7 是一款驱动放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 单电源+5V 供电时, 静态电流为 105mA。增益大于 19dB, 1dB 压缩点输出功率典型值为 18dBm。射频端均已集成隔直电容。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd} = +5V)

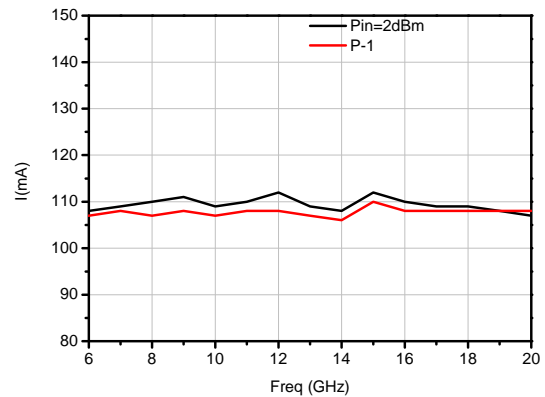
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~20		
增益(dB)	-	20	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	2	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	18	-
静态电流 (mA)	-	105	-

典型测试曲线

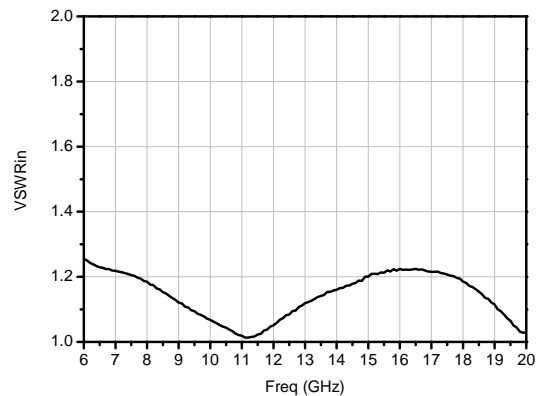
输出功率



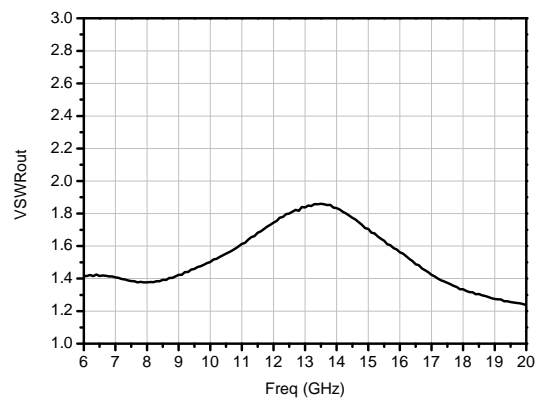
工作电流



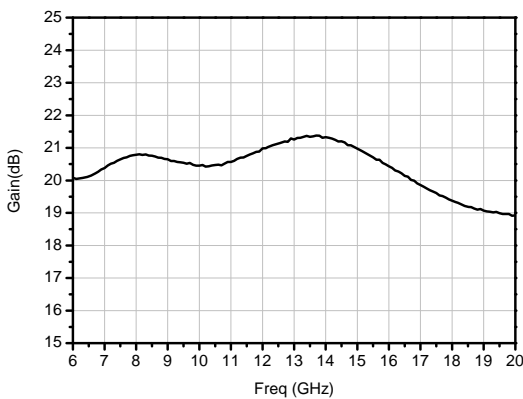
输入驻波



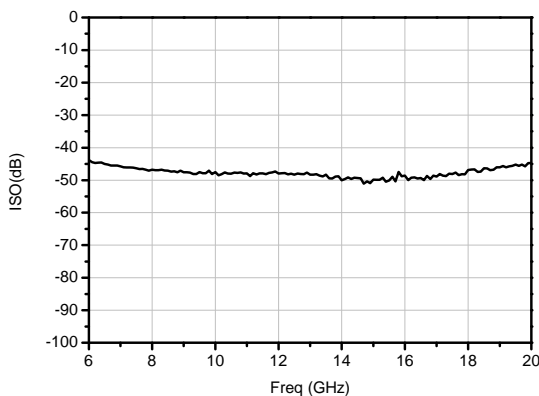
输出驻波



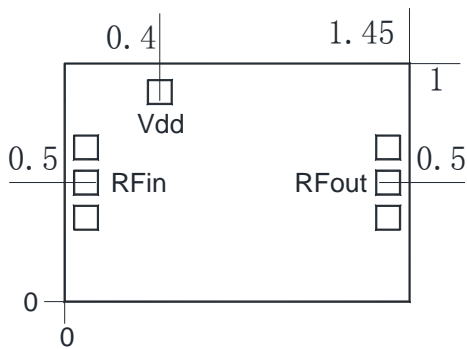
增益



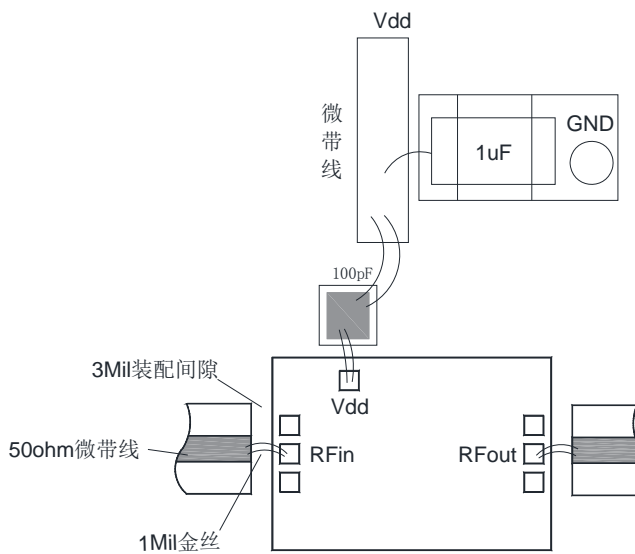
反向隔离度



外形和端口尺寸



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。